◎ 公開特許公報(A) 昭62-213839

(5) Int Cl 4

79発明者

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)9月19日

B 01 J 13/02

A - 8317 - 4G

審査請求 未請求 発明の数 2 (全10頁)

均一に被覆された複合体粒子の製造方法 64発明の名称

到特 願 昭61-57806

誓

20出 願 昭61(1986)3月14日

谷 79発 明 者 菅

護

東京都港区赤坂 4 丁目10番33号 ヘキスト合成株式会社内

東京都港区赤坂4丁目10番33号 ヘキスト合成株式会社内

安 ⑪出 願 人 ヘキスト合成株式会社

斎

東京都港区赤坂4丁目10番33号

弁理士 朝日奈 宗太 外1名 79代 理 人

日日 紅田

1発明の名称

均一に被覆された複合体粒子の製造方法

- 2 特許請求の範囲
 - 1 (A) 荷電した無機質粒子又は高分子粒子か らなるコア粒子と、
 - (B) コア粒子より小さく、かつ反対に荷電し た無機質粒子又は高分子粒子からなるシェル 形成用粒子を、シェル形成用粒子の数をコア 粒子の数で割った粒子数比(R)が

$$(R) > \frac{4 \pi (a+b)^2}{2 \sqrt{3} b^2} \times 0.5$$

「a = コア粒子の平均半径 【b ■シェル形成用粒子の平均半径】

を満足する割合で、分散液状態で混合するこ

とを特徴とするコア粒子をシェル形成用粒子 で均一に被覆された複合体粒子の製造方法。

- 2 I (A) 荷電した無機質粒子又は高分子粒子 からなるコア粒子と、
 - (B) コア粒子より小さく、かつ反対に荷電し た無機質粒子又は高分子粒子からなるシェル 形成用粒子を、シェル形成用粒子の数をコア 粒子の数で割った粒子数比(R)が

$$(R) > \frac{4 \pi (a+b)^2}{2 \sqrt{3} b^2} \times 0.5$$

「a = コア粒子の平均半径 b = シェル形成用粒子の平均半径 を満足する割合で、分散液状態で混合してコ ア粒子をシェル形成用粒子で均一に被覆した 粒子とし、この粒子を2次コア粒子として、 Ⅱ2次コア粒子より小さく、かつ反対に荷電 した無機質粒子又は高分子粒子からなる2次 シェル形成用粒子を、 2 次シェル形成用粒子の数を 2 次コア粒子の数で割った粒子数比(R)が

$$(R') > \frac{4 \pi (a'+b')^2}{2 \sqrt{3} b'^2} \times 0.5$$

を満足する割合で、分散液状態で混合することを1回以上繰り返すことを特徴とする2次コア粒子を2次シェル形成用粒子で均一に被覆された複合体粒子の製造方法。

3 高分子粒子がソープフリー製法によってえたものである特許請求の範囲第1項又は第2項記載の複合体粒子の製造方法。

3 発明の詳細な説明

ル的改質や、

回高エネルギー電子線を用いて、無機質粒子表面にピニルボリマーを結合させる改質や、 内無機物に重合開始剤、モノマー、ボ 重合 とび で で な と で で な と な ど が あ る が な こ こ と に な と な ど が あ る で な と な と い う 欠 点 が あった の 生 成 が あった。

[課題解決の手段]

本発明者らは、かかる政質方法の必要性とそれのの問題点に鑑み、無機質粒子の表面の分子粒子の表はなりでなる。の子粒子の表面を無機質粒子で均一に被覆したり、あ子粒子のは無機質粒子を増した複型した複子を増加された。反対にではないの条件で混合することによりきたないではないで、

[発明の目的]

本発明は、無機質粒子又は高分子粒子からなるコア粒子の表面を、無機質粒子又は高分子粒子からなるシェル形成用粒子で均一に被覆した複合体粒子の製造方法および該複合体粒子をコア粒子として、更にシェル形成用粒子で均一に被覆することを1回以上繰り返した複合体粒子の製造方法に関する。

[従来技術とその欠点]

従来、無機物と樹脂を配合して加工性の改善、物理的特性の改良、耐熱性の付与、難燃性の付与、耐薬品性及び電気的性質の向上などが試みられてきた。しかしながら、樹脂と無機質微粒子の樹脂への分散が困難なため、不均一な複合体しかえられず、従って各種特性にムラが生じるという欠点がある。又、改良法として、

(f) 無機物を粉砕しながら新生表面の活性によって、モノマーをグラフトさせるか、又はポリマーを切断しながらグラフトさせるメカノケミカ

めて強固にかつ均一に被覆された復合体粒子が えられることを見出し本発明を完成した。

すなわち本発明は、(A) 荷電した無機質粒子 又は高分子粒子からなるコア粒子と、(B) コア 粒子より小さく、かつ反対に荷電した無機質粒 子又は高分子粒子からなるシェル形成用粒子を、 シェル形成用粒子の数をコア粒子の数で割った 粒子数比(B) が

$$(R) > \frac{4 \pi (a+b)^2}{2 \sqrt{3} b^2} \times 0.5$$

[a = コア粒子の平均半径、 b = シェル形成用粒子の平均半径]を満足する割合で、分散液状態で混合することを特徴とするコア粒子をシェル形成用粒子で均一に被覆した複合体粒子の製造方法、およびこれを複数回繰り返して多層に被覆した複合体粒子を製造する方法である。

[構成の説明]

本発明において、無機質粒子又は高分子粒子が、他の無機質粒子又は高分子粒子で均一に被 覆された複合体粒子をつくる要件としては、

(1) 被覆する粒子(以下、シェル形成用粒子という)は被覆される粒子(以下、コア粒子という)より小さいことが必要である。

しかして、粒径分布は狭い方がより均一に被覆される。

(2)シェル形成用粒子とコア粒子は分散液状態で混合しなければならない。

③シェル形成用粒子とコア粒子は互いに反対に 荷電していなければならない。そのためには、 分散液のpHが重要なポイントとなることがある。 (4)シェル形成用粒子およびコア粒子は、無機質 粒子、高分子粒子のいずれでもよい。しかし、 実用上は無機質粒子を高分子粒子で被覆した複 合体粒子、又は高分子粒子を無機質粒子で被覆 した複合体粒子が好ましい。

(5) 均一に被覆するための最も大切な要件は、シュェル形成用粒子とコア粒子の粒子数の比、すな

最密に被覆する必要はなく、偏りなく、平均的に被覆していることが大切である。そのためには(R) はNの50%以上、好ましくは70%以上でなければならない。これを模型図として示すと第3図のようになる。

(R) がNの50% 未満では、露出部分が多くなり、そのため大きい凝集体を形成することになる。これを模型図として示すと第4図のようになる。すなわち、露出しているコア粒子の負のイオン性により疎らに被覆した正の粒子を介して他のコア粒子が密着し、凝集して大きい凝集体となる。(R)の上限はとくに制限はないが、余分のシェル形成用粒子はいたずらに浮遊しているだけであるから、実用的には150%程度が適当である。

本発明で用いる無機質粒子としては、金、銀、 銅、鉄、アルミニウムなどの金属粉、シリカ、 アルミナ、酸化鉄、酸化チタン、酸化亜鉛など の金属酸化物、炭酸カルシウム、蓚酸カルシウ ム、硫酸バリウムなどの塩などが適当である。 わちシェル形成用粒子の数をコア粒子の数で割った粒子数比(R) が次式を満足することである。

 $(R) > N \times 0.5$

$$\left(\text{但し、N} - \frac{P}{Q} - \frac{4 \pi (a+b)^2}{2\sqrt{3} b^2} \right)$$

N:コア粒子1ケの表面を最密に被覆するに 要するシェル形成用粒子の数

P: コア粒子 1 ケの表面に、シェル形成用粒子が被覆したときの表面積 = 半径 (a+b)の球面 = 4 π (a+b)² …… (第 1 図)

Q:シェル形成用粒子がコア粒子の表面を最密に被覆したときのシェル形成用粒子 1 ケ当りの占める方形の面積 = 2b×√3 b = 2√3 b² …… (第2図)

(a=コア粒子の平均半径 b=シェル形成用粒子の平均半径) 本発明に於て、均一に被覆するということは

しかして、これらの無機質粒子は、平均粒径 0.005~ 100mのものが適当である。

これらの粒子の分散液としては水性分散液が 最もよいが、イオンに解離できる程度の水分が 含有されていれば非水性分散液でもよい。使用 できる非水溶剤としてはシクロヘキサン、ヘブ タン、ヘキサンなどの無極性有機溶剤が好まし W.

無機質粒子の分散液を作るには、前述の無機質物質を粉砕し、三本ロール、ペブルミル、超音波分散などの公知の方法で水又は含水した非水溶剤に分散させるか、又はコロイドゾル合成法により合成すればよい。

このようにして、粒子径 0.005~ 100μmの範囲の無機質粒子の分散液がえられる。

えられた分散液は無機物質の種類によって正 又は負に荷電しているが、中にはpllを変えることによってで電位が変り、負又は正に変るものがある。このような荷電は、水素イオン、水酸イオン、電位決定イオン、又は高原子価を有する対イオンによってもたらされる。その改さなるでは後述する高分子粒子についても同様である。

高分子粒子の分散液は、乳化重合法や懸濁重合法によって作ることができる。又、ポリマーを後乳化することによっても作ることができる。このようにして平均粒子径 0.01 ~ 50 μm の範囲

以上の使用が好ましい。 0.01 重量部未満では えられた粒子の帯電量が不足し、本発明の目的 に使用できない。

正のボリマー末端を与える重合開始剤としては、たとえば2・2′- アソピス(2- アミジノプロパン)塩酸塩などがあげられる。負のボリマー末端を与える重合開始剤としては、たとえばの硫酸ナトリウム、過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウムなどがあげられる。これらの重合開始剤は、ラジカル重合性単量体 100重量部に対して 0.01 ~ 20重量部、ことに 0.2~10重量部の使用が好ましい。

また、正又は負のポリマー末端を与えない重合開始剤、たとえば過酸化ベンゾイル、過酸化ラウリルなどを併用してもよい。

カチオン性の重合性乳化剤としては、アルキルジメチルアンモニウムクロライドとアリルエーテル化合物との合成化合物があり、アニオン性の重合性乳化剤としては、アルキルアリルスルホサクシネートのアルカリ塩や、ビニルスル

の高分子粒子の分散液がえられる。

えられる分散液は、組成や製法によって正又は負に荷地させることができる。荷電させる方法としては、カチオン性又はアニオン性単量体、および正又は負のボリマー末端を与える重合開始剤、およびカチオン性又はアニオン性の重合性乳化剤のいずれかを選択的に単独又は併用して、必要により非イオン性単量体や他の乳化剤とともにラジカル重合する方法が用いられる。

カチオン性単量体としては、たとえばジエチルアミノエチルメタクリレート、ジメチルアミノエチルメタクリレートなどがあげられ、アニオン性単量体としては、たとえばアクリル酸、メタクリル酸などがあげられる。これらのイオン性単量体はそれぞれ単独で重合してもよく、又他の非イオン性単量体と組合せて用いてもよい。

イオン性単量体だけで荷電させるためには、 非イオン性単量体 100重量部に対して、イオン 性単量体 0.01 重量部以上、ことに 0.2重量部

ホン酸のアルカリ塩などがある。勿論他の乳化 剤と併用してもよい。

しかし乍ら、重合性乳化剤を使用するか又は全く乳化剤を使用せずに重合した、所謂ソープフリー重合法でえられた乳化重合体は、とくに均一に被覆された複合体粒子を作るために好適である。

 合し、緩やかに10分~2時間撹拌すればコア粒子にシェル形成用粒子がきわめて均一に、かつ強固に付着し、無機質粒子を高分子粒子で均一に被覆した複合体粒子の分散液がえられる。

両分散液を混合する場合、硫酸カリウム、塩化マグネシウム、塩化アルミニウムなどの無機 電解質を添加すると、より均一に、かつ緻密に 被覆することができる。これは無機電解質がシェル形成用粒子のシャドー効果を減少させるため被覆率の増加をもたらすものと考えられる。

また、ソープフリー製法による高分子粒子分散液を使用すると、より均一に、かつ強く被覆することができる。これは高分子分散液中にポリピニルアルコール、メチルセルロースなどの高分子物質や、その他いわゆる乳化剤が含まれていないので、これらによる被覆の阻害がないためと考えられる。

又、本発明によればさらに多層に複合した粒子を作ることができる。その製造方法としては、 前述によってえられた粒子表面が正又は負に荷

これは加え合わすコア粒子とシェル形成用粒子の粒子数比(R) を限定したことによるものである。

複合体粒子の完成後は、コア粒子と付着した粒子の電荷を異符号に保ちさえすれば殆んど脱離することがなく、付着粒子の電荷で安定化された複合体粒子の安定な分散系となる。

つぎに製造例、実施例、比較例をあげて本発 明を説明する。

製造例 1

機拌器、還流冷却器、滴下飆斗、温度計を備えた容量 2g の四ツロフラスコ中に水 36.1g 、28% アンモニア水 280.4g 、エタノール 793gを加えて撹拌したのち、58.3g のオルトケイ酸エチルを加え30分間撹拌した。ついで 466.6g のオルトケイ酸エチルを添加撹拌後、透析して固形分19.2%、平均粒子径 1.59 μのシリカコロイド水性分散液をえた。

製造例 2

製造例1で用いたものと同様の四ツロフラス

電し、かつ均一に被覆された複合体粒子の分散 液に、この複合体粒子より小さく、かつ反対に 荷電した無機質粒子又は高分子粒子の分散液を 添加し、ゆるやかに撹拌混合すればよい。

この操作を繰り返すことにより、より多層に被覆した複合体粒子がえられる。

[効 果]

コ中に水1750g、ジエチルアミノエチルメタクリレート17.5gを入れ、この混合液のpHが 1.2になるように塩酸を加える。ついでスチレン 158.6g、過硫酸カリウム 3.5gを入れ、窒素置換後、70℃まで昇温し、6時間重合反応を行なった。冷却後、凝集塊を除去し、透折して固形分 9.8%、平均粒子径 0.25 μmのラテックスをえた。

製造例 3

製造例 1 で用いたものと同様の四ツロフラス中に水 1512g、アクリルアミド 14g、ジメの破かりかム 4g、塩化ナトリウム 4g、過酸カリウム 6gを入れ、窒素置換後 70℃まで昇近し、1 時間重合反応を行なった。ついでなりにない、つぎにジエチルアミノエチルメタクリンと14g 加え、さらに 1 時間重合反応を行いいた 14g 加え、さらに 1 時間重合反応を行いた。冷却後、凝集塊を除去し、透析し平均粒子

製造例 4

製造例 1 で用いたものと同様の四ツロフラスコ中に水 1440g、スチレン130g、過硫酸カリウム 0.12gを入れ、70℃まで昇温し、 8 時間重合反応を行なった。冷却後、凝集塊を除去し、透析して平均粒子径が 0.44 μmのラテックスをえた。

製造例 5

製造例 1 で用いたものと同様の四ツロフラスコ中に水 1300g、ジエチルアミノエチルメタクリレート 93g、スチレン 52g、ラテムル K-180(花王石鹸㈱製のカチオン性重合性乳化剤)
18.5gを入れ、80℃まで昇温し、V-50(和光純薬工業㈱製、2.2 - アソビス(2- アミジノブロバン)塩酸塩の商品名)の 5%水溶液 30g を入れ、5 時間重合反応を行なった。冷却後、凝集塊を除去し、平均粒子径 0.06 μmのラテックスをえた。

製造例 6

製造例 1 で用いたものと同様の四ツロフラスコ中に水1400g 、スチレン70g 、メチルメタク

盂 lө ө ө ө ө ө ө 害ら 3 3 極医 表 **3**X # ~ B B B B B B B B B D D D D D D 電製 摡 赵 **3** Ξ ۵

リレート 70g、コータミン 86P コンク (花王石 鹸㈱製のカチオン乳化剤) 12g を入れ、70℃ま で昇温し、 V-50の 5%水溶液 28g を加えて、 6 時 間重合反応を行なった。冷却後、凝集塊を除去 し、粒子径 0.1μm のラテックスをえた。

製造例 1 ~ 6 の粒子について、pllと電荷の関係は第 1 表の通りであった。

[以下余白]

実施例 1

製造例 1 でえたシリカコロイド分散液を水で 5%に稀釈し、その 2.0g をとり、塩酸でpHを 6 に調整し、緩やかに撹拌した。この稀釈コロイド分散液は負に帯電していた。別に製造例 2 でえたラテックスを水で 2%に稀釈し、塩酸でpHを 6 に調製した。この稀釈ラテックスは正に帯電していた。

この稀釈ラテックスの 1.74gを、前記の稀釈 コロイド分散液に徐々に加え、緩やかに撹拌して、無機質粒子が高分子粒子で均一に被覆された複合体粒子の分散液をえた。この分散液は正に帯電していた。このときの、粒子数比(R) はN の約100%に当る。

顕微鏡で観察すると、シリカコロイドの粒子表面が充分均一にラテックス粒子で覆われており、静置により沈降しても軽く振盪するだけで容易に再分散した。

実施例2

製造例3でえたラテックスを水で10%に稀釈

し、塩酸で pllを 5 に調整した。この 稀釈の ラテックスは正に帯電していた。

実施例3

平均粒子径が 0.015 mのスノーテックス0 の10% 分散液を pll 4 に調整した。このスノーテックス分散液は負に帯電していた。このスノーテックス分散液 0.19gを実施例 1 でえた正に帯電しているシリカコロイド/ラテックス複合体粒

質粒子で均一に被覆された複合体粒子の分散液をえた。

顕微鏡で観察すると、ラテックス粒子表面が 酸化チタン粒子で充分均一に被覆されており、 静置により沈降しても軽く振盪するだけで容易 に再分散した。

実施例 5

実施例1において、稀釈ラテックスとともに 0.1モル/ Ø の硫酸カリウム水溶液 1gを添加した以外は、実施例1と同様に行なって、無機質粒子が高分子粒子で均一に被覆された複合体粒子の分散液をえた。

静置により沈降しても軽く振盪するだけで容 おに再分散した。顕微鏡で観察すると、シリカコロイド粒子の表面がきわめて密にラテックス 粒子で覆われていた。この複合体粒子を沈降させて採取し、示差熱分析法によりシリカとラテックス樹脂の比率を調べたところ、実施例1で えたものよりも約10%多くラテックス樹脂が検 出された。これは疏酸カリウムの作用によるも 子の分散被10gに徐々に添加し、緩やかに撹拌して、高分子粒子で均一に被覆された無機質粒子をさらに無機質粒子で均一に被覆した多層複合体粒子の分散液をえた。

この分散液を電気泳動装置で電荷を測定すると添加したシリカコロイドと同じ負の電荷を示し、多層複合体粒子が生成していることを証明した。 静置により沈降しても軽く振盪するだけで容易に再分散した。

実施例 4

製造例 3 でえたラテックスを水で10% に稀釈し、pllを 8.5に調整した。この稀釈ラテックスは正に帯電していた。

別に酸化チタンJR(帝国化工㈱製の平均粒子径 0.3μmのルチル型酸化チタン)をボールミルで水に分散させて 5%の水性分散液を作り、 pllを 6.5に調整した。この分散液は負に帯電していた。

この分散液 47g を前記の稀釈ラテックス10g に添加し、緩やかに撹拌して高分子粒子が無機

のと考えられる。

実施例 6

製造例 4 でえたラテックスを水で 5 % に稀釈し、塩酸で pilを 5 に調整した。このラテックスは負に帯電していた。

別に製造例 2 でえたラテックスを水で 5 %に稀釈し、塩酸で pHを 5 に 調整した。このラテックスは正に帯離していた。

この正に帯電しているラテックス76g と、前記の負に帯電しているラテックス10g を混合し、緩やかに撹拌して、高分子粒子が高分子粒子で均一に被覆された複合体粒子の分散液をえた。

えられた複合体粒子を電気泳動装置で測定すると正の電位を有しており、顕微鏡では小さいラテックス粒子が大きいラテックス粒子を充分均一に被覆しているのが観察された。

実施例7

製造例 1 でえたシリカコロイド分散液を、水で 5%に稀釈し、その 100gをとり塩酸で pllを 7 に調整した。この稀釈コロイド分散液は負に帯電

していた。

別に製造例 5 でえたラテックスを水で 2%に 稀釈 し、水酸化ナトリウムで pHを 7 に調整した。この稀釈ラテックスは正に帯電していた。この稀釈ラテックス 32.8g を前記の稀釈コロイド分散液に徐々に加え、緩やかに 撹拌して、 無機質粒子が高分子粒子で均一に被覆された複合体粒子の分散液をえた。このときの粒子数比(R) はN の約200%に当る。

えられた複合体粒子を走査型電子顕微鏡で観察すると、シリカ粒子表面がラテックス粒子で充分均一に被覆されており、静置により沈降した複合体粒子は軽く振盪するだけで容易に再分散した。

比較例1

実施例1において、系のpHを9に調整した以外は、実施例1と同様に行なった。このとき、シリカコロイドは負に帯電しており、ラテックスも負に帯電していた。

混合液中には、シリカコロイド、ラテックス

シリカ粒子表面をラテックス粒子が10~20個程度復っているものも見られたが、殆んどのシリカ粒子には数個のラテックスが被覆しているにすぎなかった。

実施例および比較例について、 製造諸元と結 果をまとめると第 2 表の通りである。

[以下余白]

ともにそれぞれ個々に分散しており、シリカ粒子をラテックスで被覆したものは見られなかった。

比較例2

実施例 1 において、稀釈ラテックスの添加量 1.74gを 0.35gに変えた以外は、実施例 1 と同様に行なった。この時の粒子数比(R) はN の約20% であった。

顕微鏡で観察すると、シリカコロイドとラテックスとが凝集して大きい凝集塊が多く生成しており、シリカ粒子をラテックス粒子で均一に被覆したものは殆んど見られなかった。

比較例 3

実施例 7 において、使用した稀釈ラテックス32.8g の代りに、製造例 6 でえたラテッスを水で 2%に稀釈し、水酸化ナトリウムで pHを 7 に調整した稀釈ラテックス57.6g に変えた以外は、実施例 7 と同様に行なった。この時、シリカコロイドは負に、ラテックスは正に帯電していた。混合後の粒子を走査型電子顕微鏡で観察すると、

<u>₹</u>	3	Φ							⊕								7				1		部	₹	יי	₩	쓢	‡)
益	2	Θ								⊕							0.2				4		×	40	٤	×	#	*
ૠ	-	Θ								Φ							-				9		#1	禌	⊅	ļo,		
例	7	Θ					⊕										2				7		旣		旣			
	9			Φ						⊕							1.5				2		ŒΧ		旣			
	2	Θ								⊕							1				9	K ₂ S0₄	旣		旣			
選	4		0								Φ						0.7				6.5		政		旣			
英	8	Φ								⊕		Φ					1		1.5		1		耍		臤			
	2		⊕			Φ			•								9.0				2		包		臤			
	-	Φ								Ф							-				8		旣		囡			
数 群	(mg)	1.59	1.8	0.44		0.015	90.0		0.10	0.25	0.30	0.015					17/		17/			\$ 	形成		数件			
		ን ህ ክ .	P(St/AM/DEAM)	P(St)		> y n n 2)	P(St/DEAM/重合性	乳化剂)	P(St/MMA、86p)	P(St/DEAM)	酸化チタンJR	シリカ ²⁾					一次シェル形成用粒子/	コア粒子	二次シェル形成用粒子/	二次コア粒子	Нd	超 解 質	合体粒子の	(括 一 柱)	仮合体粒子の再分散性	(民雄年)		
		п	۲	#	+	八八	用次	哲シ	₹×	₹	*	弘	战次	用ド	拉工	北土		(E)	<u></u>				粒		#2			

P(St/AN/DEAN):製造例3の粒子 シリカ¹⁾:製造例1の粒子 P(St):製造例4の粒子

P(St/DEAN/重合性乳化剤):製造例5の粒子 シリカ2):スノーテックス0

P(St/MMA、86p):製造例6の粒子

田は粒子の電荷を示す。

4 図面の簡単な説明

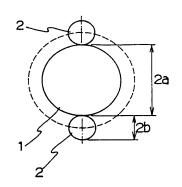
第1図と第2図は、コア粒子1ケの表面を最 密に被復するに要するシェル形成用粒子の数N の算出を説明する図面であるが、第1図の点線 が1回転した面積がPであり、第2図はシェル 形成用粒子1ヶ当りの占める面積Qを示す。

第3図は、均一に被覆された複合体粒子の模 型図であり、第4図は、疎らに被覆された複合 体粒子の凝集状態を示す。

なお、図面において用いられている符号にお いて、1はコア粒子であり、2はシェル形成用 粒子である。又、⊕は正電荷を示し、⊖は負電 荷を示す。

特許出願人 ヘキスト合成株式会社 代理人弁理士 朝日奈宗太 ほか 1 名

才 1 図



H

才2 図

